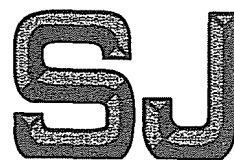


ICS 31.260

L45

备案号:



中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 11394—2009

代替SJ/T 2355.1~2355.7—1983

半导体发光二极管测试方法

Measure methods of semiconductor light emitting diodes

2009-11-17 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

复制必究
版权所有

目次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语、定义和符号.....	1
4 一般要求.....	3
4.1 试验条件.....	3
4.2 测量条件(允许偏差).....	4
4.3 测量设备.....	4
5 测试方法.....	4
5.1 测试方法分类.....	4
5.2 1000类 电特性测试方法.....	4
5.3 2000类 光特性测量方法.....	7
5.4 3000类 光电特性测量方法.....	12
5.5 4000类 颜色特性测量方法.....	12
5.6 5000类 热学特性测量方法.....	16
5.7 6000类 静电放电敏感性测试和分类.....	20



前 言

本标准代替SJ/T 2355.1~2355.7—1983《半导体发光器件测试方法》系列标准，与SJ/T 2355—1983相比主要变化如下：

- 增加了半导体发光二极管的色度学参数、热学参数和静电放电敏感性的测试方法；
- 采用国际照明委员会CIE 127-1997《技术报告 LED的测量》中建立的平均LED强度的概念和测量规范来替代原先建立在点光源基础上的发光强度测量方法；
- 鉴于可见光和红外发射二极管、紫外发射二极管的测试原理相同，只是测试用探测器光谱范围不同，因此，红外发射二极管和紫外发射二极管的相关测试可以参考本标准。

本标准由工业和信息化部电子工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中国光学光电子行业协会光电器件分会。

本标准主要起草人：鲍超。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- SJ/T 2355.1—1983；
- SJ/T 2355.2—1983；
- SJ/T 2355.3—1983；
- SJ/T 2355.4—1983；
- SJ/T 2355.5—1983；
- SJ/T 2355.6—1983；
- SJ/T 2355.7—1983。